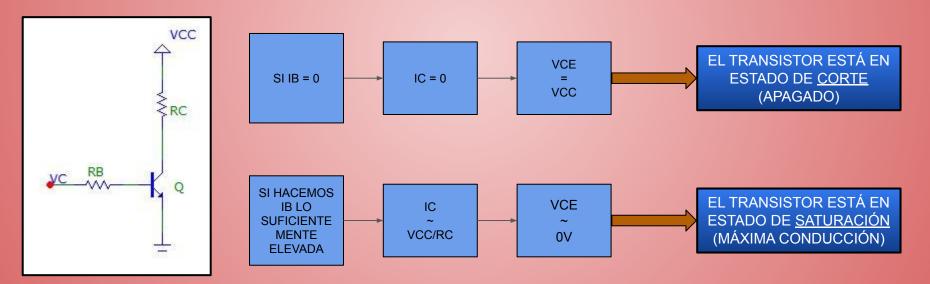
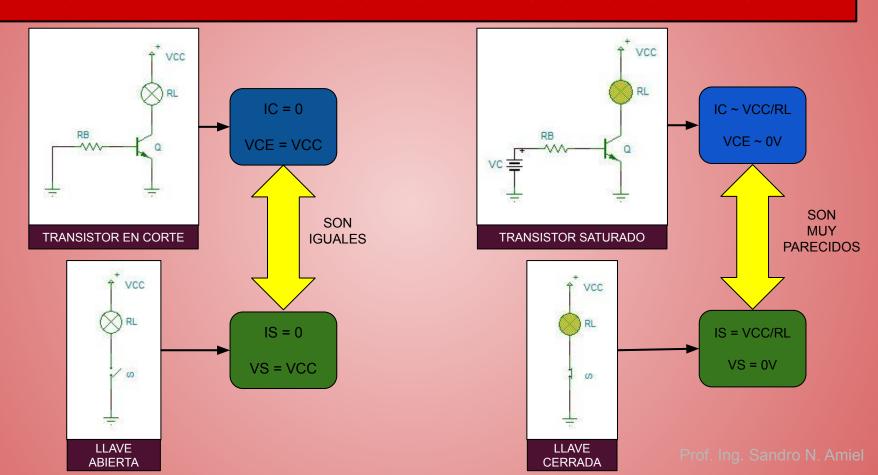


ESTADOS DE CORTE Y SATURACIÓN DEL TRANSISTOR

Manejando la corriente de base IB podemos llevar al transistor del estado de CORTE (apagado) al de SATURACIÓN (máxima conducción)



COMPAREMOS LAS SIGUIENTES SITUACIONES



COMPARANDO LOS ESTADOS ELÉCTRICOS DEL TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACIÓN CON LOS DE UNA LLAVE ABIERTA Y CERRADA RESPECTIVAMENTE PODEMOS VER QUE SON MUY PARECIDOS

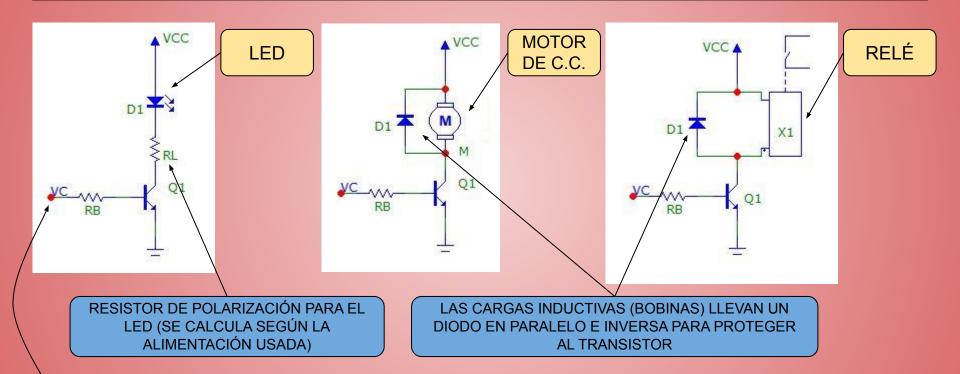
ENTONCES

PODEMOS USAR TRANSISTORES
PARA ENCENDER Y APAGAR
(CONMUTAR) CARGAS QUE
TRABAJEN CON TENSIÓN CONTINUA,
LAS QUE SE CONECTARÁN EN EL
COLECTOR GENERALMENTE

ES DECIR QUE EL TRANSISTOR EN CORTE Y SATURACIÓN TRABAJA COMO UNA "LLAVE ELECTRÓNICA" CONTROLADA POR UNA PEQUEÑA CORRIENTE DE BASE.

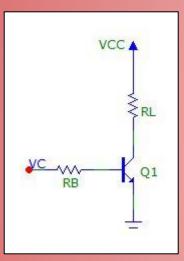
LO USAMOS PARA CONTROLAR LEDS, MOTORES DE CONTINUA, RELÉS, OTROS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MEDIANTE LA SALIDA DE POR EJEMPLO MICROCONTROLADORES, COMPUERTAS LÓGICAS, INTEGRADOS TIPO 555, ETC.

EJEMPLOS DE CARGAS QUE PODEMOS MANEJAR



LA TENSIÓN "VC" PROVIENE DEL CIRCUITO DE CONTROL (555, COMPUERTA LÓGICA, MICROCONTROLADOR, ETC.)

SELECCIÓN DEL TRANSISTOR Y POLARIZACIÓN



Para poder seleccionar un transistor apropiado y polarizarlo debemos conocer algunos datos de la carga que queremos conmutar: su tensión de alimentación y su corriente de trabajo, es decir VL e IL.

El transistor debe ser capaz de conducir la corriente IL cuando está saturado y soportar la tensión VL cuando está en corte.

Luego VCC = VL e IC = IL.

Tenemos que buscar un transistor que soporte un poco más que estos valores. Generalmente podemos utilizar el siguiente criterio:

ICmáx. > 1,5 x IL VCEmáx > 1,5 x VL

RL representa a la carga que se quiere conmutar (LED, motor, relé).

VC es la tensión del circuito de control (compuerta, 555, microcontrolador, etc.)



Parameter	Symbol	Values BC 337	BC 338	Unit
Collector-emitter voltage	V _{CE0}	45	45 25	
Collector-base voltage	V _{CB0}	50	30	
Emitter-base voltage	VERO			
Collector current	<i>I</i> c	800		mA <
Deel eellesten soment	7		- A	
DC current gain ¹⁾ Ic = 100 mA; VcE = 1 V	hre			-
BC 337/1	6; BC 338/16	100	160	250

DC current gain ¹⁾	hfe				_	20
$I_{\rm C} = 100 \text{mA}; V_{\rm CE} = 1 \text{V}$	630.040.04					
BC 337/16; BC 3	38/16	100	160	250		
BC 337/25; BC 3	338/25	160	250	400		
BC 337/40; BC 3	38/40	250	350	630		
$I_{\rm C} = 300 \text{ mA}; V_{\rm CE} = 1 \text{ V}$						
BC 337/16; BC 3	338/16	60	-			
BC 337/25; BC 3	338/25	100	-	_		
BC 337/40; BC 3		170	-	-		_
					2000	

Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_{\text{C}} = 500 \text{ mA}; I_{\text{B}} = 50 \text{ mA}$	VCEsat	-		0.7	V	7
Base-emitter saturation voltage $I_C = 500 \text{ mA}$; $I_B = 50 \text{ mA}$	V_{BEsat}	_	-	2		<u>_</u>

ESTA ES LA TENSIÓN MÁXIMA QUE SOPORTA ENTRE COLECTOR Y EMISOR EN CORTE

ESTA ES LA CORRIENTE MÁXIMA QUE PUEDE CONDUCIR EN SATURACIÓN

ESTE ES EL HFE QUE
PRECISAMOS PARA
LOS CÁLCULOS. SUELE
HABER TRES
COLUMNAS: MÍNIMO,
TÍPICO Y MÁXIMO.
EN CONMUTACIÓN
USAMOS HFE MÍNIMO

ESTA ES LA MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN EN EL TRANSISTOR SATURADO

ESTA ES LA MÁXIMA CAÍDA BASE - EMISOR EN SATURACIÓN (NO SIEMPRE ES 0,7V)

Prof. Ing. Sandro N. Amiel

Una vez que tenemos el transistor adecuado (y su hoja de datos) podemos calcular la RB necesaria para polarizarlo correctamente en saturación: La corriente de colector que va a conducir el transistor es la corriente de la carga, es decir

$$IC = IL$$

La IB necesaria para llevarlo al comienzo de la saturación se obtiene así:

$$IB = \frac{IC}{HFE}$$

Pero esta corriente, como dijimos antes, lo lleva al borde de la saturación. Si queremos asegurarnos de que sature tenemos que tomar un valor mayor a este. Un criterio válido es tomar el doble de este valor, o sea:

$$IB_{SAT} = 2 x \frac{IC}{HFE}$$

Teniendo IB_{SAT} podemos aplicar la Ley de Kirchhoff en la malla de entrada para poder despejar RB:

$$VC = IB_{SAT} \times RB + VBE$$

 $VC - VBE = IB_{SAT} \times RB$

Entonces:

$$RB = \frac{VC - VBE}{IB_{SAT}}$$

Podemos reemplazar IB_{SAT} por la expresión anterior:

$$RB = \frac{VC - VBE}{2 x \frac{IC}{HFE}}$$

$$RB = \frac{HFE(VC - VBE)}{2 \times IC}$$

Además del valor de RB necesitamos calcular su potencia. Podemos hacerlo de la siguiente forma:

$$PRB = \frac{VRB^2}{RB}$$

$$PRB = \frac{(VC - VBE)^2}{RB}$$

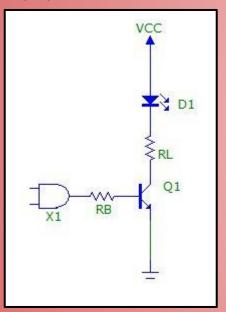
Debemos tener en cuenta además la potencia que disipa el transistor cuando satura, porque no debe exceder al valor máximo indicado en la hoja de datos e incluso en algunos casos puede ser necesario colocarle un disipador (que se calcula también).

La potencia disipada por el transistor es aproximadamente:

$$PD_{TOTAL} = IC \times VCE_{SAT}$$

EJEMPLO

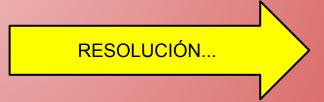
Se debe conectar un LED a la salida de un circuito de compuertas lógicas que trabaja con 12V. Dibujar y calcular el circuito apropiado.



Datos:

- LED (típico): IL = 10mA, VL = 2V
- Compuerta: salida aprox. igual a la alimentación (12V en este caso)
- VCC = 12V

De la carga a controlar (LED con su resistencia de polarización) vemos que el transistor debe conducir 10mA en saturación y soportar 12V en corte. Podemos usar un BC548B (ICmax 100mA; VECo = 40V; HFE = 300; VCEsat = 0,1 V; VBEsat 0,7V)



Calculamos RB:

$$RB = \frac{HFE(VC - VBE)}{2 \times IC} = \frac{300(12 - 0.7)}{2 \times 10 \times 10^{-3}} = 169.5k\Omega$$

Adoptamos un valor comercial cercano (para abajo):

$$RB = 150k\Omega$$

En código de colores sería: (Marrón - Verde – Amarillo)

Calculamos ahora la potencia que va a disipar:

$$PRB = \frac{(VC - VBE)^2}{RB} = \frac{(12 - 0.7)^2}{150 \times 10^3} = 0.85 mW$$

(Observar que ya usamos el valor comercial de RB).

En cuanto a la potencia, las resistencias vienen de:

1/8W (125mW)

1/4W (250mW)

1/2W (500mW)

1W

2W

5W

7W

10W

(Luego de a 5W, aunque puede depender del fabricante).

Debemos colocar una resistencia cuya potencia sea mayor a la que va a disipar en el circuito, para que no se dañe.

En nuestro caso podemos adoptar la más chica (1/8W). Luego:

$$RB = 150k\Omega - 1/8W$$

Falta calcular la resistencia del LED:

$$RL = \frac{(VCC - VL)}{IL} = \frac{(12 - 2)}{10 \times 10^{-3}} = 1k\Omega$$

Este es justo un valor comercial.

En colores: (Marrón - Negro - Rojo)

$$PRL = \frac{(VCC - VL)^2}{RL} = \frac{(12 - 2)^2}{1 \times 10^3} = 100mW$$

Podemos usar una resistencia de 1/8W, o también de 1/4W. Luego:

$$RL = 1k\Omega - 1/4W$$

La potencia que disipa el transistor:

$$PD = VCE_{SAT} \times IC = 0.1 \times 10 \times 10^{-3} = 1mW$$